Villeneuve d'Ascq, IEMN du 22 au 24 mai 2018

Atelier GDR CNRS Pulse

Préparation des substrats pour l'épitaxie



Charles Cornet (INSA Rennes)

« La préparation du Silicium pour l'hétéroépitaxie »

Christophe Figuet (SOITEC)

« La préparation des substrat SOI pour l'intégration hétérogène »

Session 2 Structuration des substrats par gravure

Luc Favre (IM2NP)

« La préparation des substrats de Si pour la croissance de nanostructures SiGe »

Chantal Fontaine (LAAS) & Laurent Cerutti (IES)

« La préparation des substrats III-V pour la reprise d'épitaxie»

Session 3 L'épitaxie sélective III-Nitrures

Guy Feuillet (CEA-LETI)

« Croissance sélective de matériaux nitrures : technologies et applications aux structures émissives »

Session 4 Croissance VLS et croissance sélective de matériaux III-V

Sébastien Plissard (LAAS)

« Préparation des substrats pour la crois<mark>s</mark>ance <mark>VL</mark>S de nanofils »

Ludovic Desplanque (IEMN)

«Préparation des substrats pour la croissance sélective de matériaux III-V »

+ Session Posters

LILLE

IEMN Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie

U.M.R C.N.R.S 8520 Laboratoire Central – Cité Scientifique Avenue Poincaré 59652 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Inscription gratuite avant le 2 avril 2018 https://atelier-pulse.sciencesconf.org









